

2SB1017

シリコンPNP三重拡散形

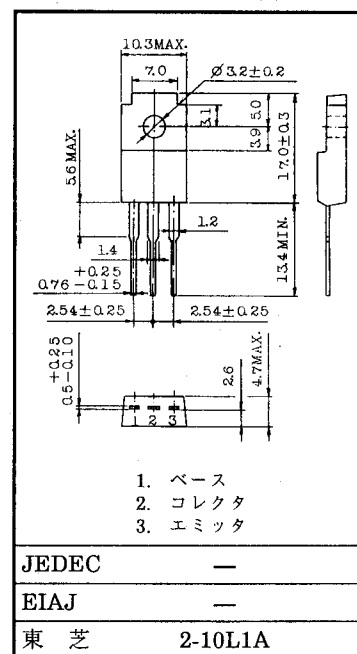
○ 電力増幅用

- h_{FE} の直線性が良い。
- 2SD1408とコンプリメンタリになります。
- 20~25Wハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。

最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-4	A
ベース電流	I_B	-0.4	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	25	W
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

単位：mm



電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = -80\text{V}, I_E = 0$	—	—	-30	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$	—	—	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -50\text{mA}, I_B = 0$	-80	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -0.5\text{A}$	40	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -3\text{A}$	15	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -3\text{A}, I_B = -0.3\text{A}$	—	-1.0	-1.7	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -3\text{A}$	—	-1.0	-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -0.5\text{A}$	—	9	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$	—	130	—	pF

注： $h_{FE(1)}$ 分類 R：40~80, O：70~140, Y：120~240